INHALTSVERZEICHNIS

1 Einleitung

Diese Arbeit beschreibt die Entwicklung und den Test einer elektronischen Kamera. Sie besteht aus einem einzigen hochintegrierten Halbleiterschaltkreis, der sowohl die Photosensoren als auch das komplette Auslesesystem enthält. Ihr Einsatzgebiet ist eine portable Orientierungshilfe für blinde und stark sehbehinderte Personen. Dieses System wird momentan als Gemeinschaftsprojekt der Institute für Angewandte Physik und Hochenergiephysik der Universität Heidelberg entwickelt. Die Grundidee dabei ist die Umwandlung optischer Informationen in mechanische Reize, die über den Tastsinn wahrgenommen werden. Dieses Konzept des taktilen Sehens wurde schon Anfang der siebziger Jahre entwickelt, scheiterte damals aber an der technischen Realisation [1,2]. Zum einen war die Elektronik zu voluminös um tragbar zu sein, zum anderen gab es kaum Möglichkeiten der Bildverarbeitung. Durch den gewaltigen Fortschritt im Bereich der Mikroelektronik ist die nötige Technik heutzutage leicht portabel zu realisieren. Auch bei der Bildverarbeitung kann man inzwischen auf erprobte und theoretisch verstandene Algorithmen zurückgreifen, wodurch wir hoffen, daß es möglich sein wird, dem Betroffenen die optischen Informationen so aufzubereiten, daß er sie durch seinen Tastsinn aufnehmen und verstehen kann.

Im gegenwärtigen Stand der Entwicklung besteht das System aus einer Kamera, deren Aufbau und Funktionsweise im folgenden noch ausführlich beschrieben wird, einem portablen Computersystem, das die Bilddaten in Kantenbilder reduzierter Auflösung umsetzt und einem mit Aktuatoren besetzten Gürtel, der diese auf die Haut des Patienten überträgt [3,4].

Schaltkreise, die wie der in dieser Arbeit vorgestellte Kamerachip, Photosensoren und weiterverarbeitende Elektronik gemeinsam auf einem Halbleiterbaustein integrieren, bezeichnet man als Visionchips. Fast immer werden sie in CMOS[1]-Technologie gefertigt, da diese durch ihre große kommerzielle Bedeutung leicht verfügbar ist und hohe Packungsdichten erlaubt. Ein Vorteil der Visionchips gegenüber den normalerweise als Bildsensoren verwendeten CCD[2]-Bausteinen liegt im größeren Kontrastumfang. Der Intensitätsunterschied zwischen Sonnenlicht und Mondschein beträgt etwa 6 Dekaden, ein Wert, den ein Visionchip bewältigt. Ein CCD-Sensor kann nur 3 bis 4 davon abdecken, man benötigt eine zusätzliche Steuerung des Lichteinfalls, z.B. durch eine Blende, um ihn an die Lichtverhältnisse anzupassen. Während dies bei zeitlichen Kontrasten eine Lösung darstellt, sind Gegenlichtverhältnisse für eine solche Kamera ein unlösbares Problem. Es ist aber sehr wichtig, daß ein System zur Blindenhilfe nicht bei jedem entgegenkommenden Scheinwerfer funktionsuntüchtig wird.

Visionchips ermöglichen massiv parallele analoge Bildverarbeitungsmethoden, da man die nötige Elektronik direkt neben jedem Sensorelement integrieren kann. Solche komplexen Pixel können optischen Informationen ähnlich vorverarbeiten, wie es in der Augennetzhaut eines Wirbeltieres geschieht. Beispiele dafür finden sich in [5]. Bei CCD-Bausteinen werden die Signale seriell ausgegeben, d.h. sie liegen zwangsläufig zeitlich quantisiert vor, zeitkontinuierliche Verfahren sind nicht realisierbar.

[1] Complementary Metal Oxid Semiconductor

[2] Charge Coupled Device

Nachteilig bei Visionchips ist die im Vergleich zur CCD-Kamera geringere Auflösung. Ein Pixel benötigt beim heutigen Stand der Technologie mindestens das Zehnfache an Fläche. Daher kommen sie als bildgebende Verfahren in der Videotechnologie momentan nicht in Frage. Für alle Bereiche künstlichen Sehens, wie z.B. die Robotik, in denen die verwendbare Auflösung durch die Leistung der nachgeschalteten Bildverarbeitungssysteme beschränkt ist, sind Visionchips aber eine lohnende Alternative. Auch das taktile Sehen fällt in diesen Bereich. Die Auflösung des Systems ist vom Tastsinn und den mechanischen Aktuatoren begrenzt. Die Kamera soll unter allen natürlich vorkommenden Lichtverhältnissen funktionieren und dabei so klein sein, daß sie problemlos in ein Brillengestell eingepaßt werden kann. Auch soll es möglich sein, zwei dieser Chips zu einer Stereokamera zusammenzuschalten, um Entfernungen bestimmen zu können. Ein integrierter Digital/Analog-Wandler vereinfacht dabei den Anschluß an ein herkömmliches Computersystem zu Weiterverarbeitung. Im Moment ist dies ein tragbarer Personalcomputer, der leicht durch ein miniaturisiertes System, wie z.B. ein CARD-PC der Firma Epson oder ein spezielles Bildverarbeitungs-ASIC[3], ersetzt werden kann.

[3] Application Specific Integrated Circuit

2 Adaptive Photosensoren

Der große Vorteil eines Visionchips liegt im großen dynamischen Bereich von mehr als 6 Dekaden. Allerdings läßt sich dieser kaum ausnutzen, hätte man einen linearen Zusammenhang zwischen Ausgangsspannung und Lichtintensität. Eine direkte digitale Repräsentation davon würde 20 Bit benötigen und die Signalamplitude bei schwacher Beleuchtung läge in der Größenordnung von Mikrovolt. Daher wird der Photostrom, der proportional zur einfallenden Intensität ist, üblicherweise logarithmiert. Zum einen kann man damit den Dynamikbereich des Eingangssignals auf einen beliebigen Ausgangsbereich komprimieren, zum anderen erhält man eine bessere Repräsentation der Bildstruktur. Verschiedene Objekte unterscheiden sich voneinander, indem sie unterschiedliche Bruchteile des auf sie treffenden Lichts in Richtung Kamera streuen. Dadurch werden auf dem Bildsensor Bereiche unterschiedlicher Helligkeit erzeugt. Deren Verhältnis zueinander hängt nicht von der absoluten Intensität ab. Nach einer Logarithmierung des Signals erhält man feste Differenzen, näherungsweise unabhängig von der Entfernung, dem Betrachtungswinkel und den vorhandenen Lichtquellen. Dies erleichtert eine spätere Rekonstruktion der im Bild dargestellten Objekte.

Die Kompression der Dynamik hat allerdings den Nachteil, daß geringe Kontraste noch kleiner werden und eventuell kaum noch aufzulösen sind. Eine Möglichkeit, dieses Problem zu lösen, haben T. Delbrück und C. A. Mead in [6] vorgestellt. Den von ihnen dazu entwickelte CMOS-Schaltkreis hat M. Loose aus unserer Arbeitsgruppe als Basis für einen adaptiven Photosensor benutzt, der nach erfolgreichem Test eines Prototyps jetzt in Form einer Matrix aus 64×64 Bildpunkten den Sensorbereich des Kamerachips bildet.

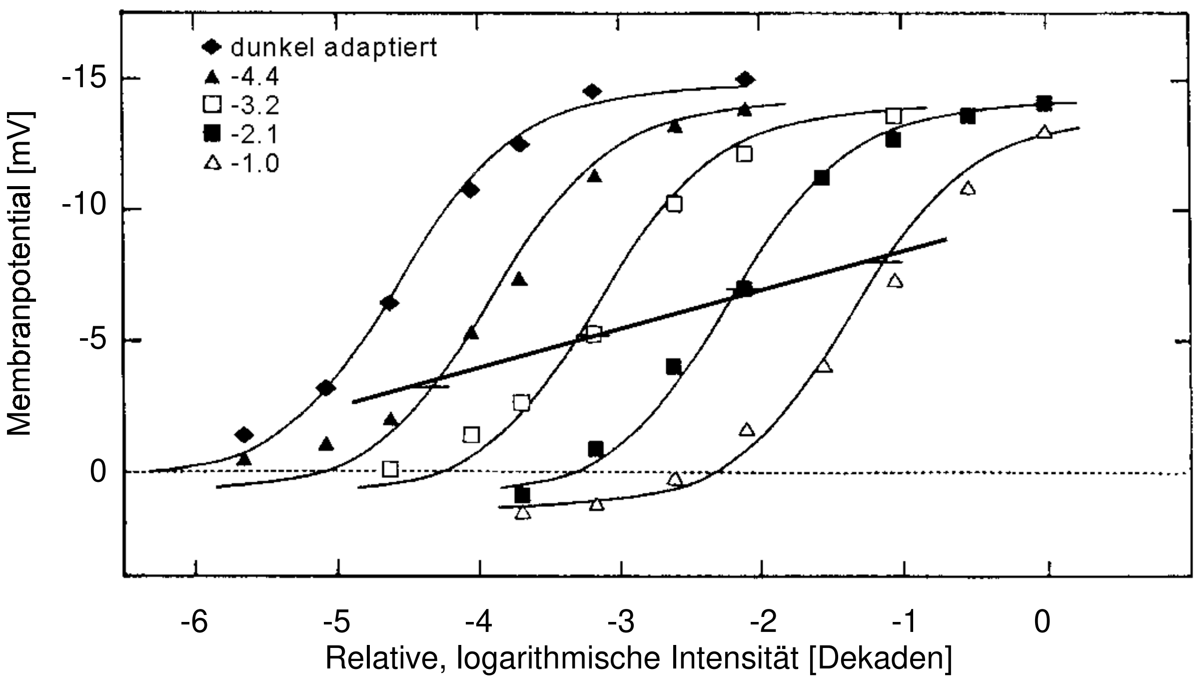

Abbildung 1: Reaktion eines Zapfens aus der Retina einer Schildkröte auf statische und transiente Reize (entnommen aus [7]).

Das Prinzip ist dem biologischen Vorbild einer Sinneszelle aus der Netzhaut nachempfunden. Abbildung 1 zeigt die Reaktion eines rotempfindlichen Zapfens aus der Schildkrötenretina auf verschiedene Lichtsignale, entnommen aus [7]. Das Membranpotential ist über dem Logarithmus der Intensität, bezogen auf eine maximale Intensität von 20 W/m^2, aufgetragen. Die flache Linie zeigt die Antwort der Zelle nach zwei Minuten konstanter Beleuchtung. Diese statische Reaktion hat eine deutlich geringere Steigung als die Reaktion auf transiente Reize, die durch die markierten Kurven dargestellt wird. Von der in der Legende angegebenen Grundintensität aus wurde die Beleuchtung schlagartig geändert. Jeder Meßpunkt entspricht dem Membranpotential bei einem dieser schnellen Lichtwechsel. Die Zelle komprimiert also den Dynamikbereich je nach Änderungsgeschwindigkeit der Lichtintensität unterschiedlich stark und paßt sich dabei immer an die aktuelle Grundhelligkeit an. Durch diese Adaptation werden Lichtwechsel unabhängig von der Hintergrundbeleuchtung wiedergegeben. Schwache Kontraste können so durch Augenbewegungen verstärkt werden, sich bewegende Objekte treten hervor.

Dieses Verhalten wird von der Schaltung aus Abbildung 2 nachgeahmt. Sie wurde von M. Loose in einer 1,2 µm CMOS-Technologie verwirklicht. Der eigentliche Photosensor ist eine parallel zur Chipoberfläche orientierte Diode, gebildet aus einer stark negativ dotierten Kathode und dem schwach positiv dotierten Substrat darunter als Anode. Da sie in Sperrichtung gepolt ist, verbreitert sich die Grenzschicht. Einfallende Photonen des sichtbaren und nahen infraroten Lichts können Elektron-Loch-Paare erzeugen, die im elektrischen Feld der Grenzschicht getrennt werden und zu einem der Lichtintensität proportionalen Strom durch die Diode führen. Der große Dynamikumfang dieser Anordnung ist darin begründet, daß die untere Grenze vom Sperrstrom, die obere vom Schmelzpunkt des Siliziums gebildet wird. Man kann also in beide Richtungen bis an physikalische Extrema des Materials gehen.

Unter natürlichen Beleuchtungsbedingungen werden allerdings nur Stromstärken von pA bis µA erreicht. Die Logarithmierung des Photostroms geschieht über den als T_{fb} bezeichneten MOS-Feldeffekttransistor. Er arbeitet im Subthreshold-Bereich, d.h. die Spannung zwischen Gate und Source ist kleiner als die Schwellspannung von etwa 0,7 Volt, ab der sich im Kanal die Inversionsschicht ausbildet. In diesem Betriebsmodus wächst der Drain-Strom I_D exponentiell mit der Gate-Source-Spannung U_{GS}.

$$I_D = I_0 e^{U_{GS}/nU_{Term}} \left(1 - e^{-U_{DS}/U_{Term}}\right)$$

I_0 ist dabei eine von den Prozeßparametern und der Geometrie des Transistors abhängige Konstante, n beträgt etwa 1,5 und U_{Term} ist das *thermische Spannungsäquivalent*[4]. Hält man das Gate-Potential U_{cap} fest, muß die Source-Spannung dem Logarithmus des durch das einfallende Licht erzeugten Stroms folgen. T_n, T_{cas} und T_p bilden einen invertierenden Verstärker, über den das Signal zum Ausgang gelangt. Die Rückkopplung der Ausgangsspannung auf U_{cap} bestimmt die besonderen Eigenschaften der Schaltung. Die Ladung des Kondensators C_1 repräsentiert die mittlere Intensität, auf die sich der Regelkreis eingestellt hat. Im vollkommen adaptierten Zustand ist U_{cap} gleich der Ausgangsspannung U_o. Erhöht sich die Beleuchtung um einen kleinen Betrag, steigt der Photostrom und U_s sinkt. Die Ausgangsspannung nimmt um die Änderung von U_s mal der Ausgangsverstärkung zu. Dadurch wird C_1 über einen speziellen, sehr hochohmigen Widerstand, das adaptive Element, auf den neuen Wert von U_o umgeladen. Steigt U_{cap}, verschiebt sich auch die Source-Spannung von T_{fb}, da der Drain-Strom, vom Photostrom vorgegeben, konstant bleiben muß. Damit wird die Änderung der Ausgangs-

[4] $V_{Term} = kT/e$ mit der Boltzmannkonstante k, der Temperatur T und der Elementarladung e.

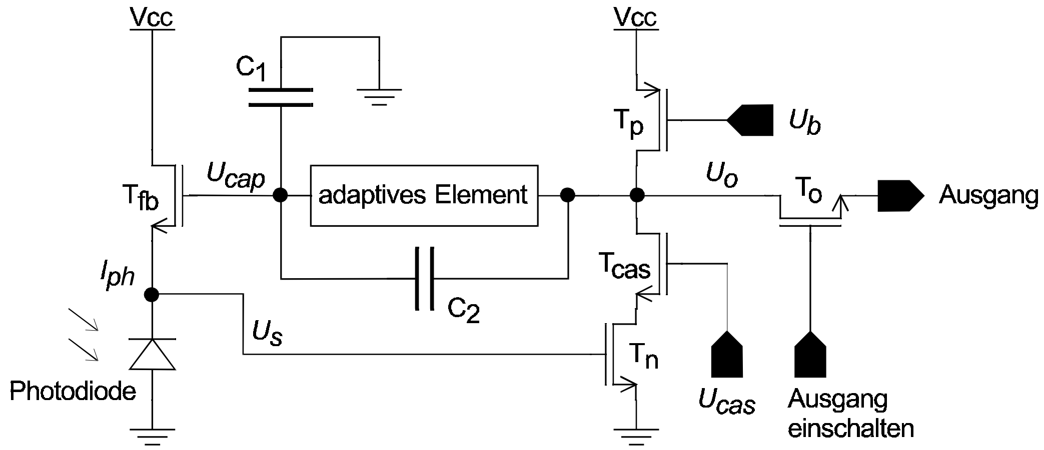

Abbildung 2: Schaltplan eines adaptiven Pixels

spannung wieder zurückgenommen. Diese negative Rückkopplung bewirkt bei statischen Signalen eine sehr flache logarithmische Kennlinie.

Transiente Signale können das Potential an U_{cap} über C_2 ändern. C_1 und C_2 bilden dann einen kapazitiven Spannungsteiler, der im Gegensatz zum adaptiven Element nur einen Bruchteil der Ausgangsspannung rückkoppelt. Damit ist die Steigung der Ausgangskennlinie steiler als bei statischen Signalen. Der Vergleich mit der Netzhautzelle zeigt, daß diese Schaltung deren Verhalten gut nachbildet. Abbildung 3 zeigt die gemessene Reaktion dieses Pixels auf transiente und statische Lichtsignale. Der nutzbare Dynamikbereich beträgt 7 Dekaden.

Das adaptive Element wird aus einem p-Kanal MOS-Transistor und einem parasitären bipolaren PNP-Transistor gebildet. Bei kleinen Spannungsdifferenzen liegt sein Widerstand in der Größenordnung von 10^{12} Ohm. Zusammen mit der Kapazität des Kondensators C_1 von 600 fF ergibt sich daraus eine Zeitkonstante von τ=RC=0,6 s. Durch die nichtlineare Kennlinie sowohl des MOS- als auch des bipolaren Transistors nimmt der Widerstand mit zunehmender Spannung ab. Dies hat den Vorteil, daß bei starken Kontrastsprüngen der Pixel schnell adaptiert, während er sich bei kleinen Schwankungen der Beleuchtungsintensität nur langsam auf einen neuen Wert einstellt.

Die Bias-Spannungen U_b und U_{cas} erlauben eine Justierung des Verstärkers. Vor allem mit U_b läßt sich der Querstrom durch T_n und T_p einstellen. Dadurch kann die Bandbreite reguliert werden. Da in einer Matrixanordnung nicht jeder Pixel eine eigene Ausgangsleitung haben kann, schaltet T_o die Spannung U_o auf die gemeinsame Leitung.

In der Abbildung 4 ist die Anordnung der Bauelemente auf dem Chip, das Layout, zu sehen. Alle Verbindungsleitungen sind so verlegt, daß sich die Pixel zu einer Matrix zusammenfügen lassen. Jeder Pixel belegt eine Fläche von 4096 µm^2. Da alle pn-Übergänge wie Photodioden lichtempfindlich sind, ist die obere Metallage als Abschirmung über die gesamte Schaltung, ausgenommen der eigentlichen Photodiode, ausgedehnt. Leider besitzt diese Abdeckung zwischen den Pixeln unvermeidbare Lücken, da die Metallschicht auch zur Verdrahtung benötigt wird und der Mindestabstand von 1,8 µm, der zwischen den Leitungen eingehalten werden muß, einen Durchlaß für einfallendes Licht bildet.

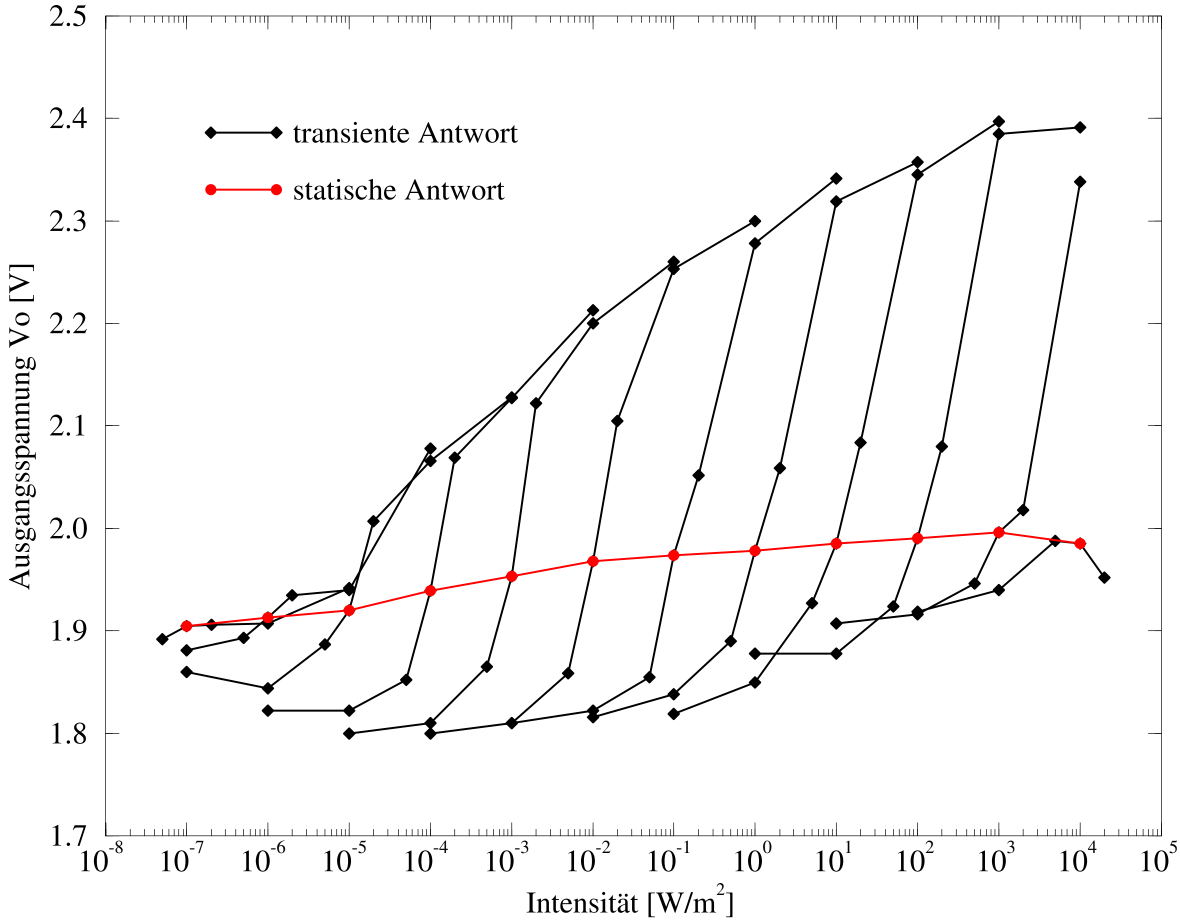

Abbildung 3: Gemessene Reaktion eines Pixels auf statische und transiente Signale

```
ERROR: typecheck
OFFENDING COMMAND: getinterval

STACK:

1
/1
[(                               )(   DD""    DD""    DD""    DD""  )(
                               )(                                )(
                               )(                                )(
                               )(                                )(
          @@               @@     )(    ""AA  AA""       ""AA  AA""   )]
[16 0 0 -16 -0.5 15.5 ]
true
16
16
1254.0
-savelevel-
-mark-
```